ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

การวัดค่า โมบิลิตีของผลิกคอป เปอร์อิน เดียม-

ไดริลิไซด์

ชื่อผู้เชียน

นายบดินทร์ สุขบท

วิทยาศาสตรมหาบันทิต

สาหาการสอนฟิสิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

ผศ-ดร-นิยม บุญญนอม ผศ-ดร-บรรจบ ยศสมบัติ ผศ-ดร-ศรีเน็ญ ท้าวตา ประชานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เป็นการวัดค่า โมบิลิตีของประจุฬาหะ (Charge carriers) ของผลิก คอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์ (Cuinse) ที่อุณหภูมิห้อง โดยอาศัยปรากฏการณ์ฮอลล์ (The Hall effect) ผลิกที่ใช้ในการทดลองมีลักษณะรูปร่างเป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ความ หนาต่างกัน ก่อนการวัดค่าสภาพนำไฟฟ้า นำผลิกไปแอนนีล เพื่อทำจุดสัมผัส โอห์มมิค (Ohmic contact) จากการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ และกระแสไฟฟ้าที่ อุณหภูมิต่าง ๆ ในช่วง 300K ถึง 473K พบว่าสภาพนำไฟฟ้าไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมิ ซึ่งมีค่า ประมาณ 0.202 ± 0.007 (ก-cm) า จากการวัดค่าสนามไฟฟ้าฮอลล์ พบว่าผลิกตัว อย่างเป็นสารกิ่งตัวนำชนิดพี (P-type semiconductor) มีค่าโมบิลิตีของประจุฬาหะ ประมาณ 17.227 cm²/v.s และความหนาแน่นของประจุฬาหะประมาณ 7.7x10¹s cm²

Research Tittle Mobility Measurement of Copper Indium Diselenide
Crystal

Author

Mr. Bodin Sukahbot

M.S.

Teaching Physics

Examining Committee:

Assist. Prof. Dr.Niyom Boonthanom

Chairman

Assist. Prof. Dr. Banchob Yotsombati

Member

Assist. Prof. Dr.Sripen Towta

Member

## Abstract

The mobility of charge carriers in Copper Indium Diselenide Crystal (CuInSe<sub>2</sub>) was measured by means of the Hall effect method at room temperature. The samples in the rectangular shape with different thickness were prepared and annealed to make an ohmic contact for the I - V measurements. The electrical conductivity from I - V characteristics in the range of temperatures 300K to 473K was about  $0.202 \pm 0.007$  ( $\Omega$ -cm)<sup>-1</sup> and was temperature independent. From the Hall field measurements the crystal showed the P - type semiconductor with the mobility and the charge carriers concentration of about 17.227 cm<sup>2</sup>/V.s and 7.7 x  $10^{16}$  cm<sup>-3</sup> respectively.